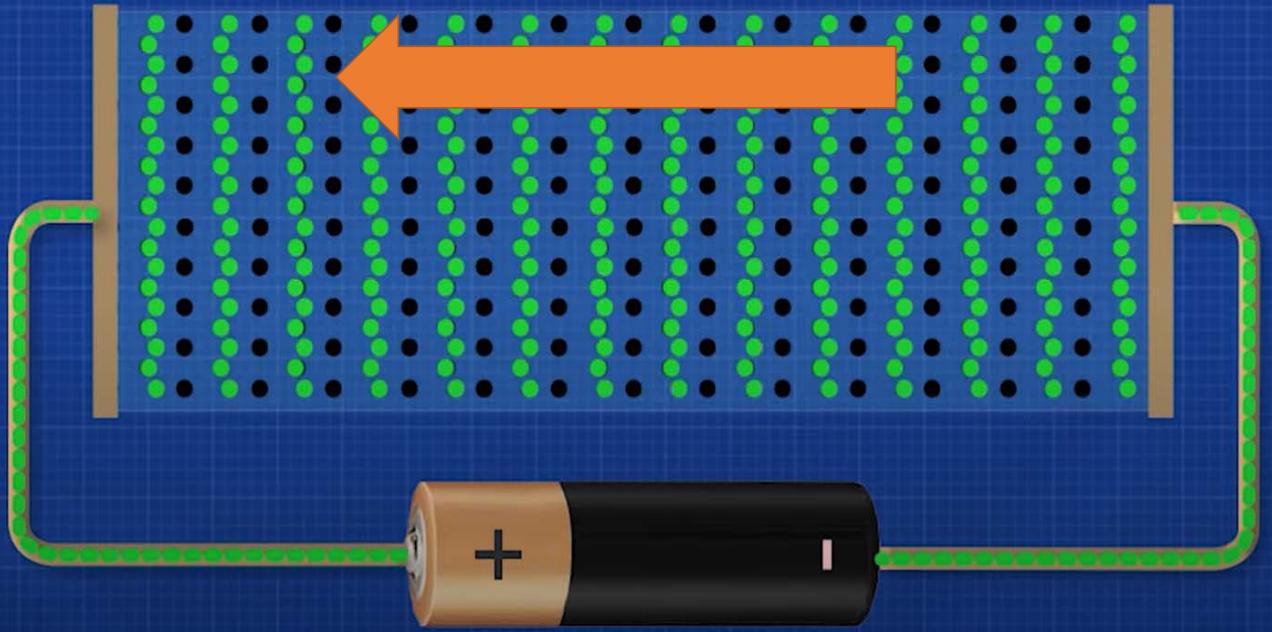


순 바이어스

P 타입

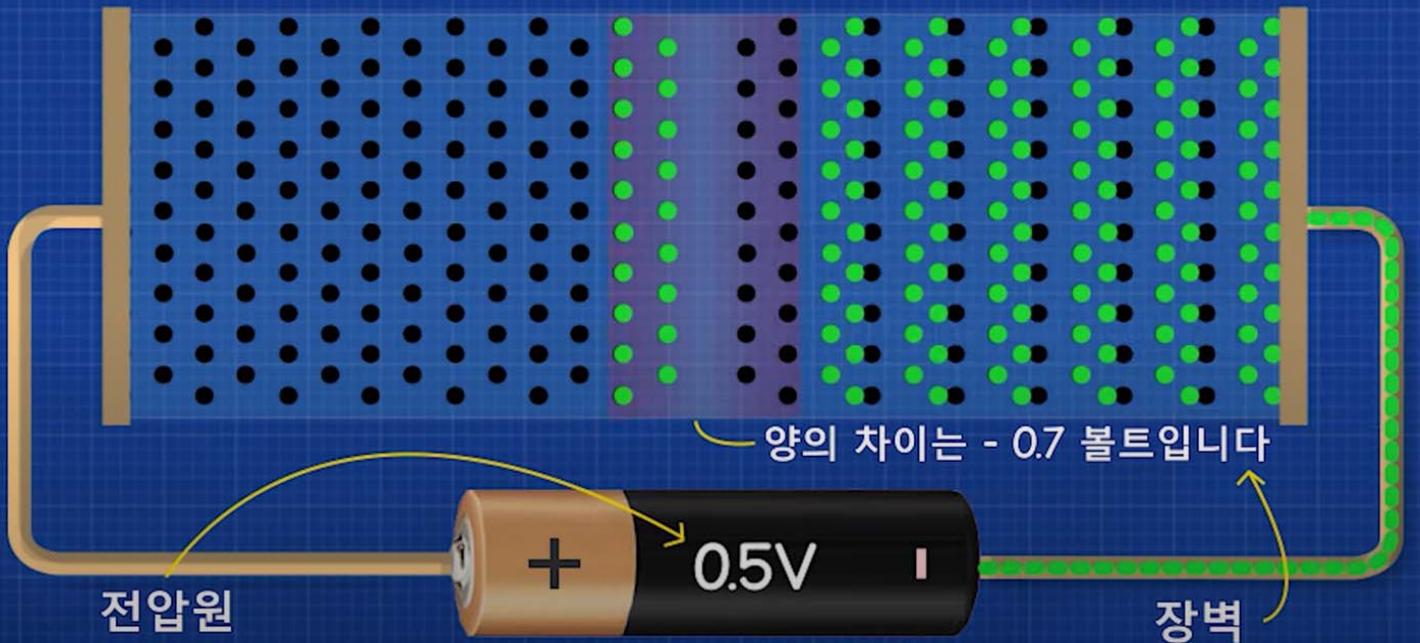
N 타입



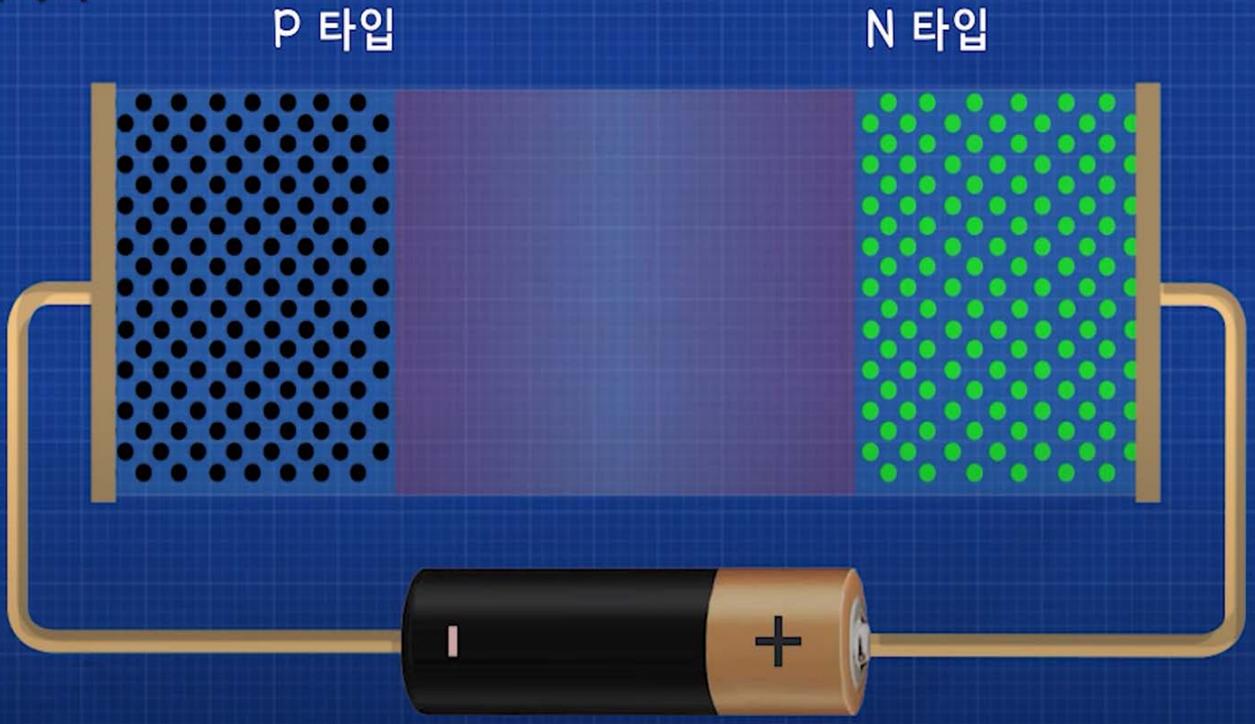
전류가 흐르려면 전압원이 장벽보다 커야 합니다

P 타입

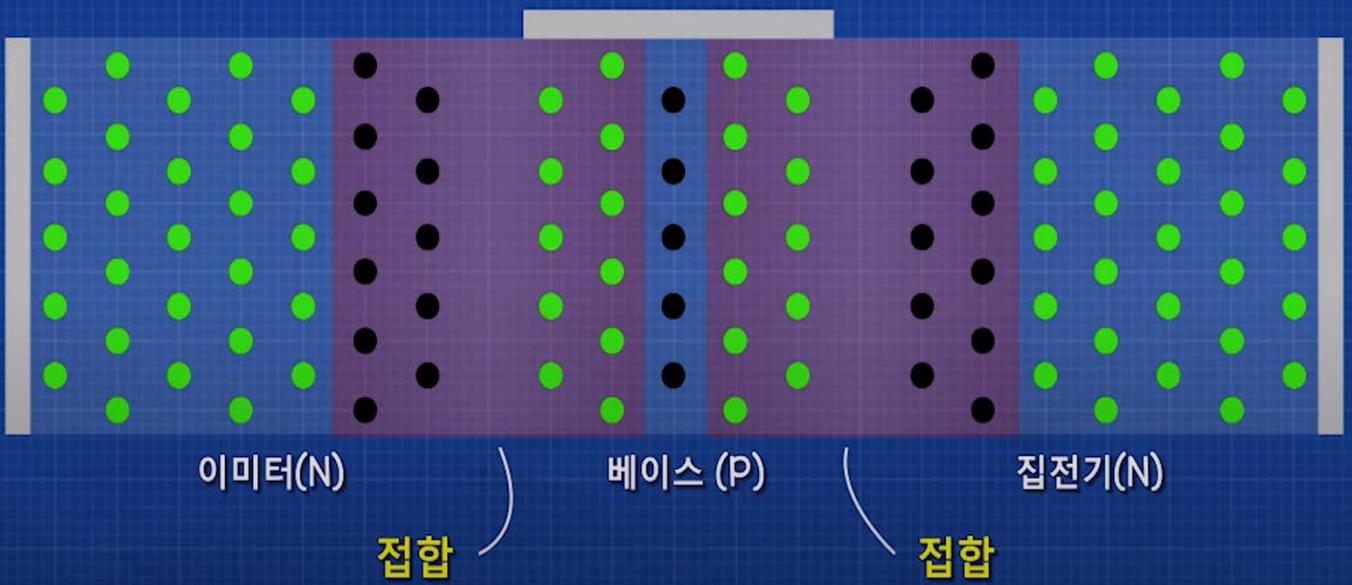
N 타입



# 역방향 바이어스



# NPN 트랜지스터

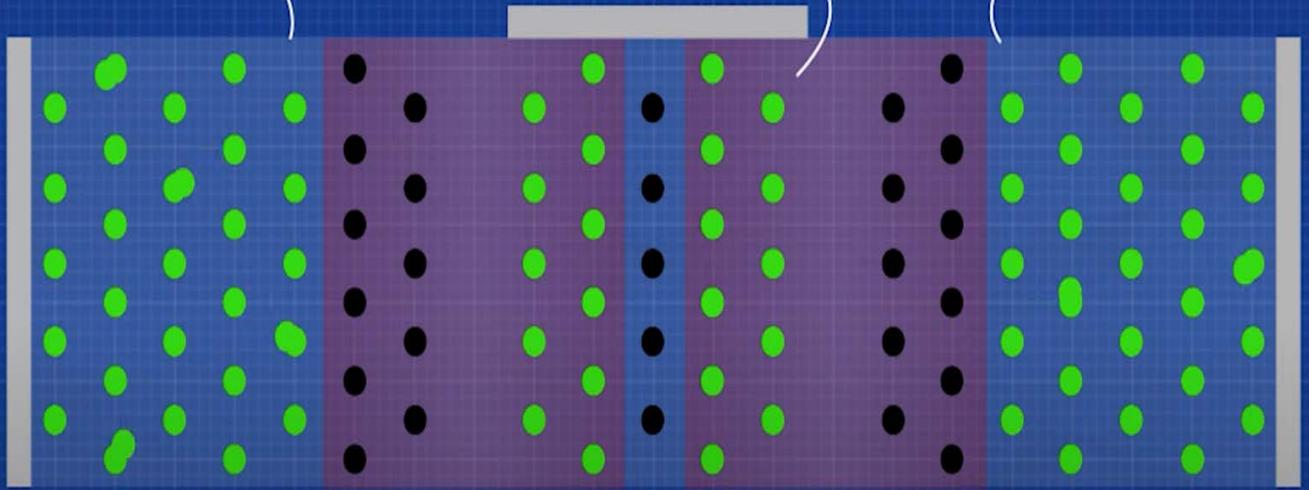


# NPN 트랜지스터

심하게 도핑 되었습니다  
많은 과잉 전자들

가볍게 도핑 되었습니다  
몇 개의 구멍이 존재합니다

적당히 도핑 되었습니다  
몇 개의 초과 전자들



이미터(N)

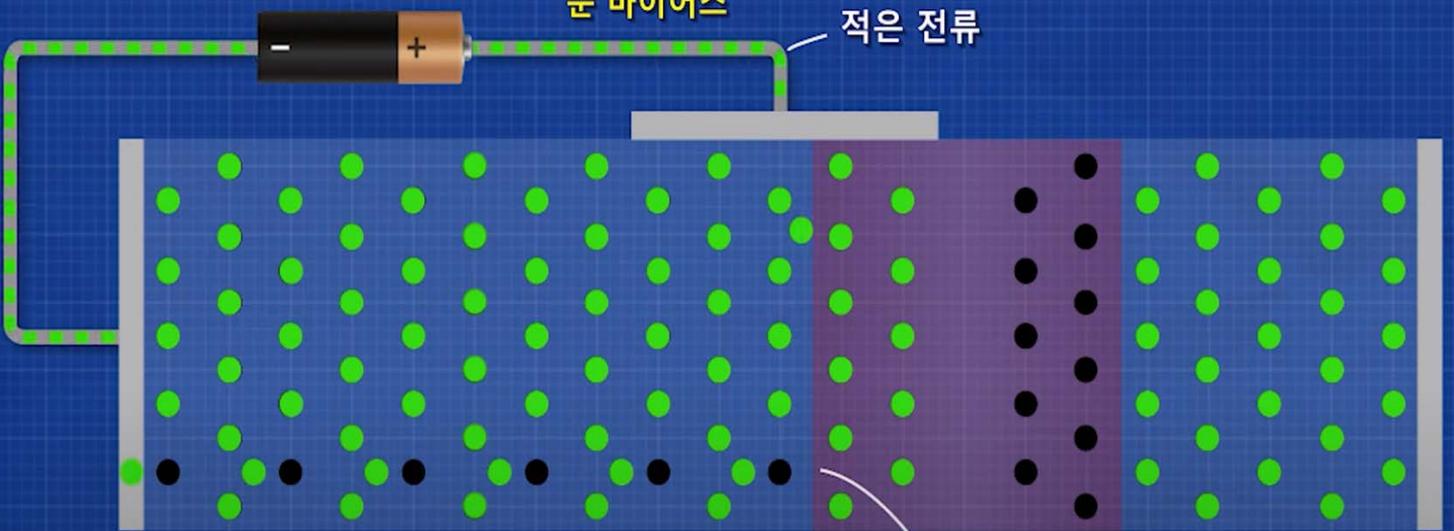
베이스 (P)

집전기(N)

# NPN 트랜지스터

순 바이어스

적은 전류



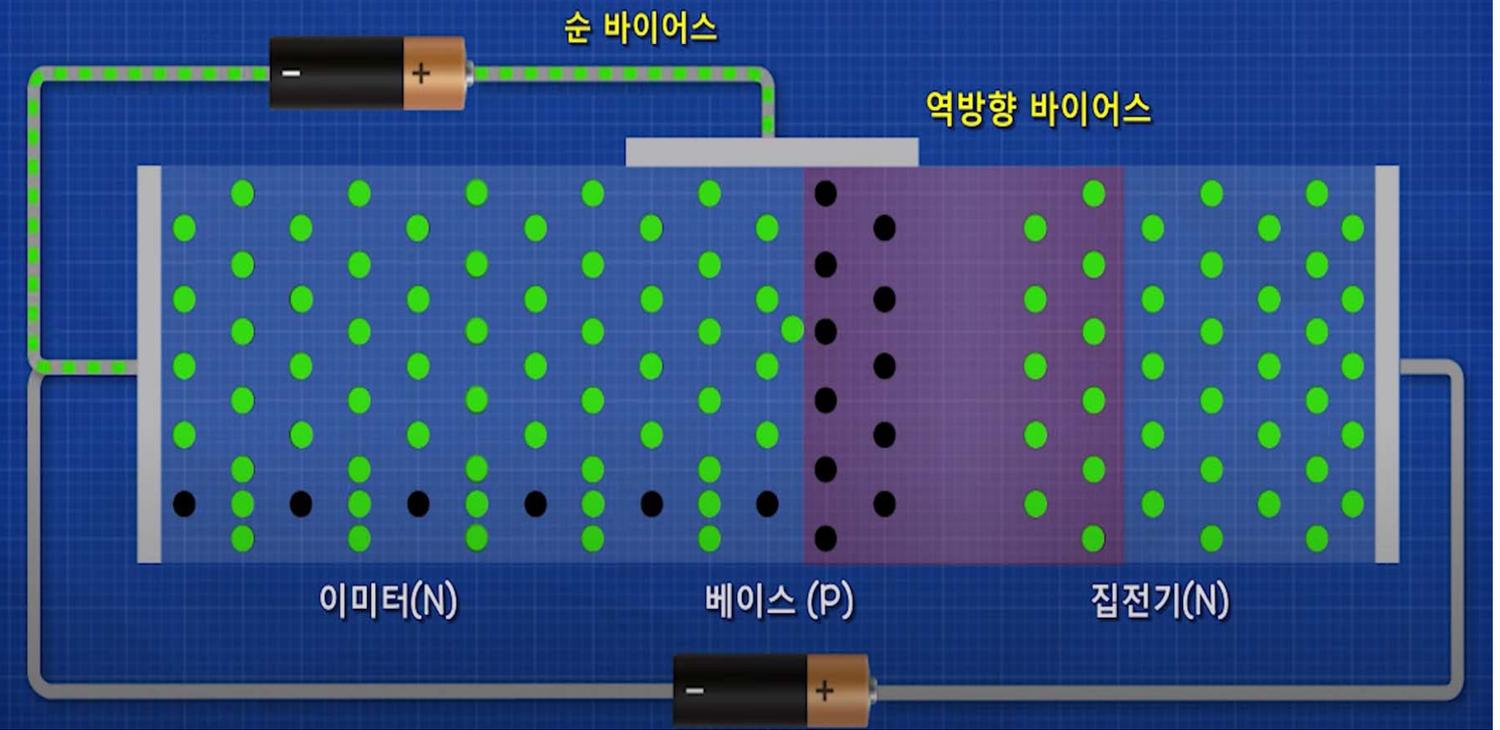
이미터(N)

베이스 (P)

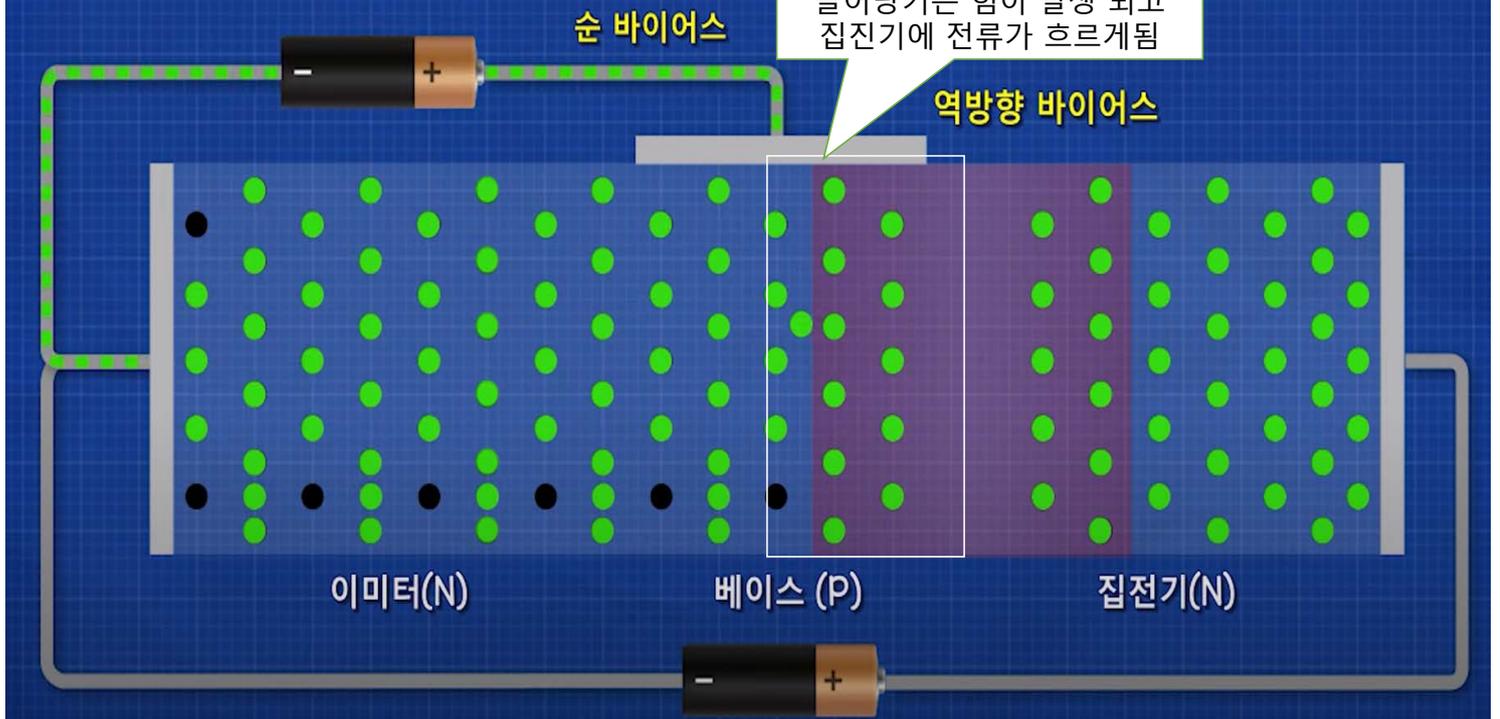
집전기(N)

많은 전자가 물질 내부에  
남아있게 됩니다

# NPN 트랜지스터

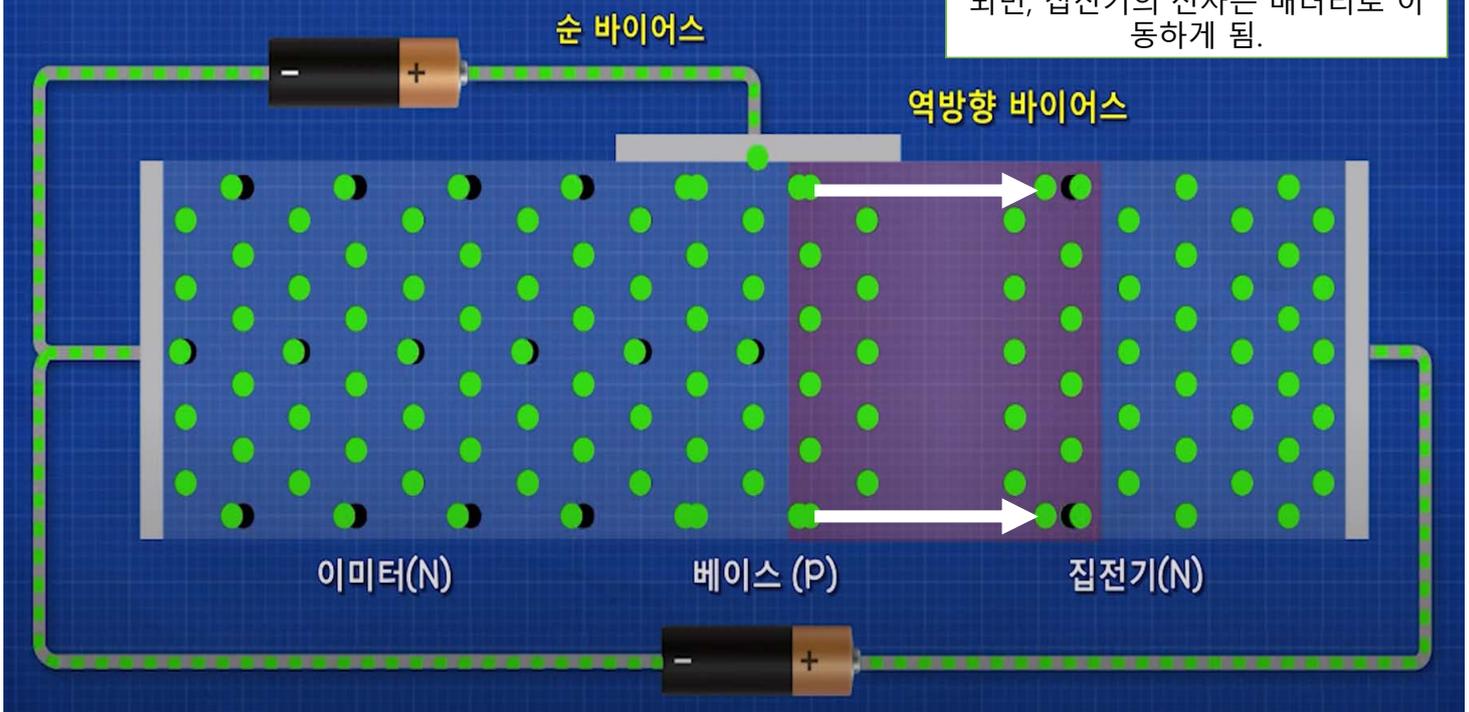


# NPN 트랜지스터



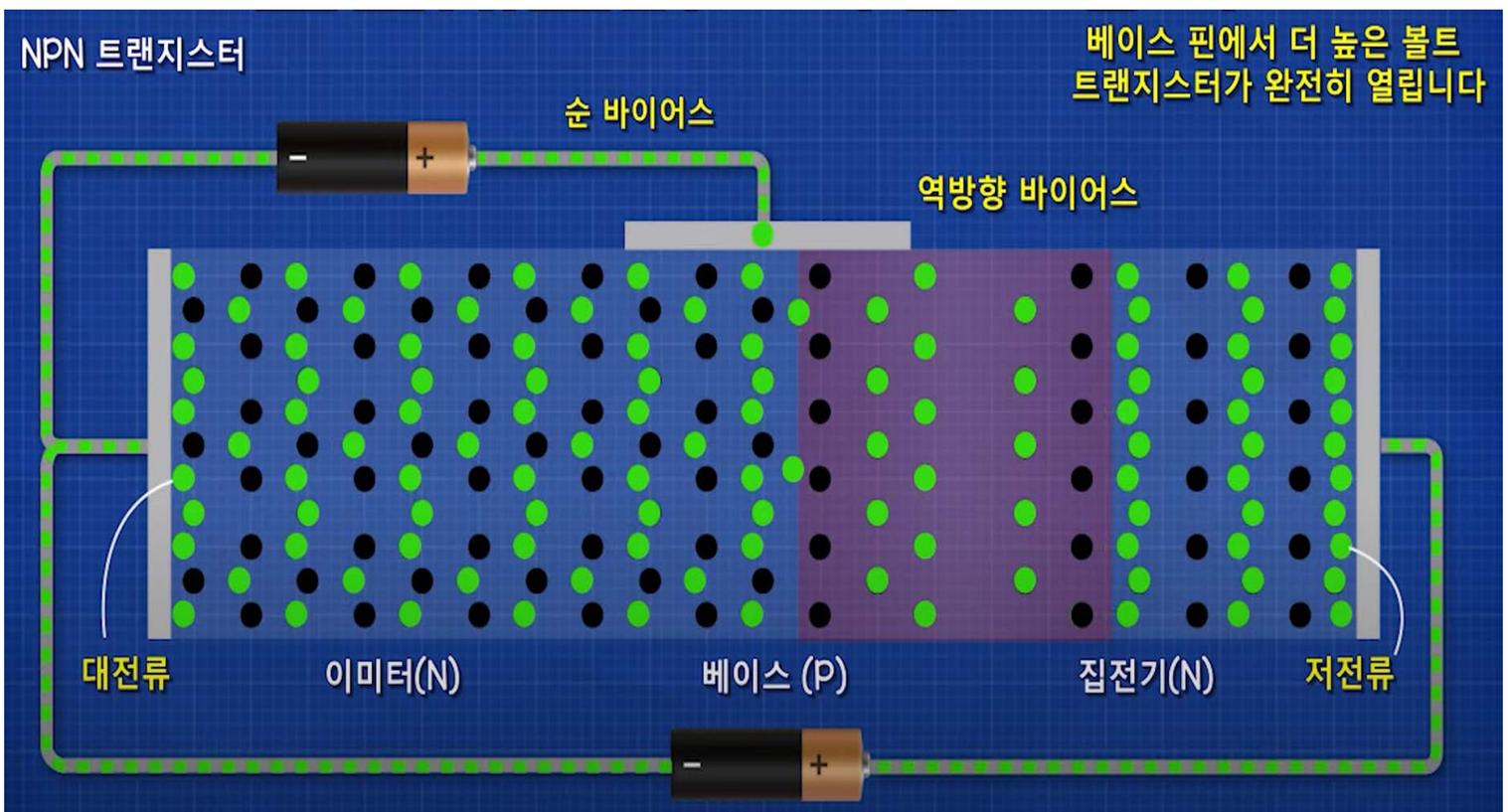
# NPN 트랜지스터

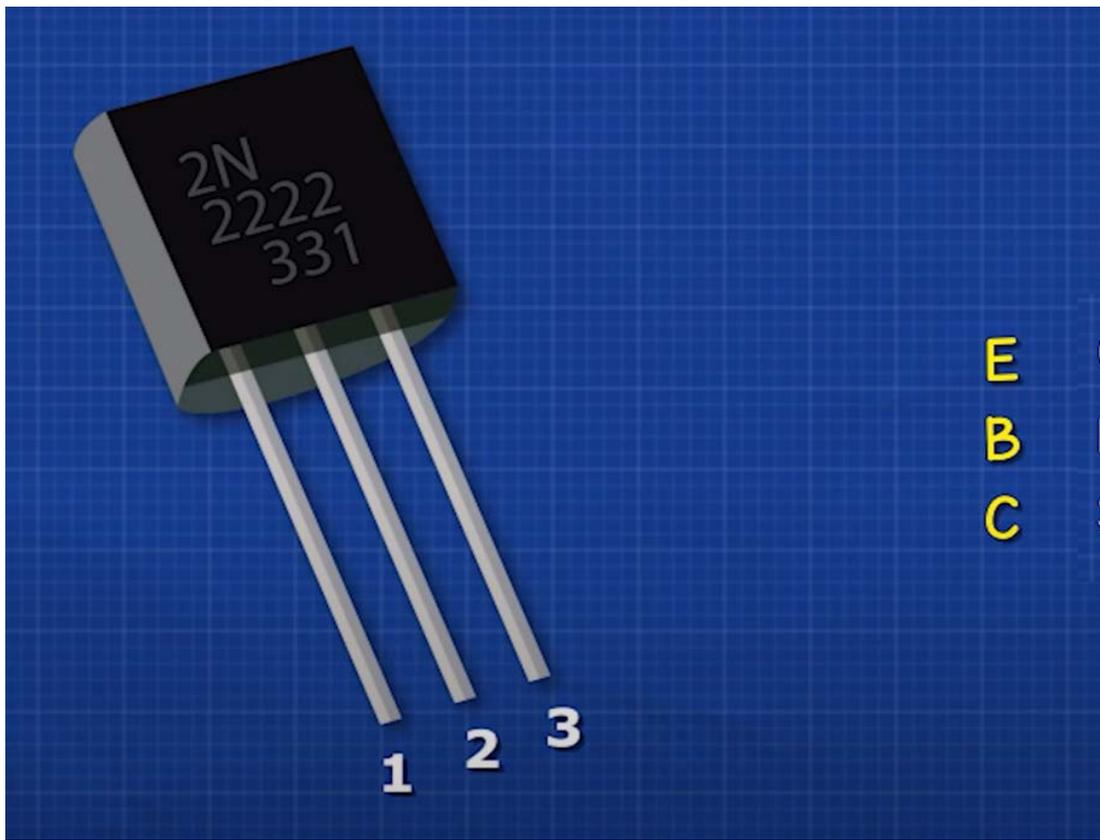
베이스에서 집진기로 전자가 흐르게 되면, 집진기의 전자는 배터리로 이동하게 됨.



# NPN 트랜지스터

베이스 핀에서 더 높은 볼트 트랜지스터가 완전히 열립니다



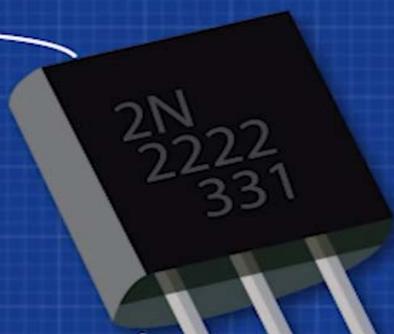


E 이미터  
 B 베이스  
 C 집전기

**일반적인 구성**

평평한  
가장자리

둥근 가장자리



이미터

베이스

집전기

모든 트랜지스터가 이 구성을 사용하는 것은 아닙니다  
 제조업체 데이터시트를 확인하십시오

이미터  
 베이스  
 집전기